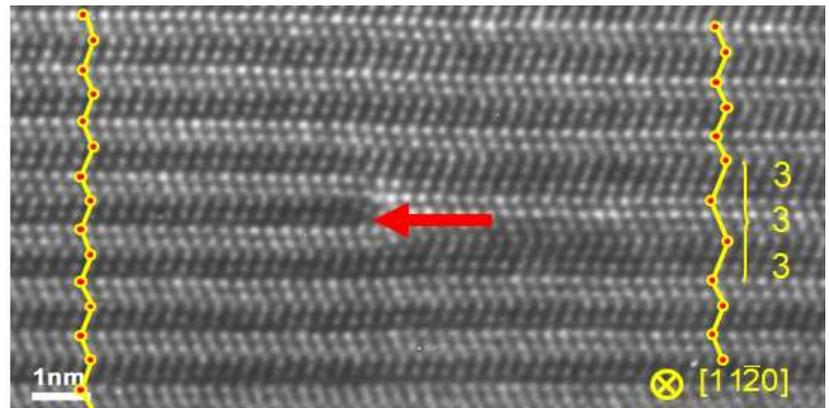
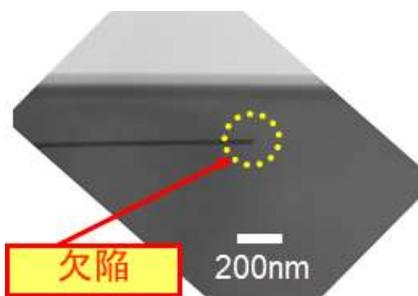
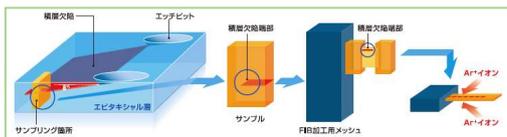


15. 結晶工学

SiCでは、積層欠陥の構造観察や注入条件の最適化、電気特性評価など、GaNでは高温注入を行った基板の欠陥評価やチャネリング現象の評価など、ITCの物理分析技術を駆使して化合物半導体の様々な評価に取り組んでまいりました。

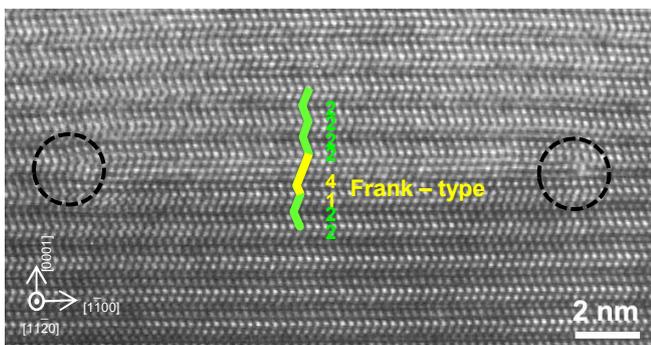
TEMによるSiC結晶構造評価



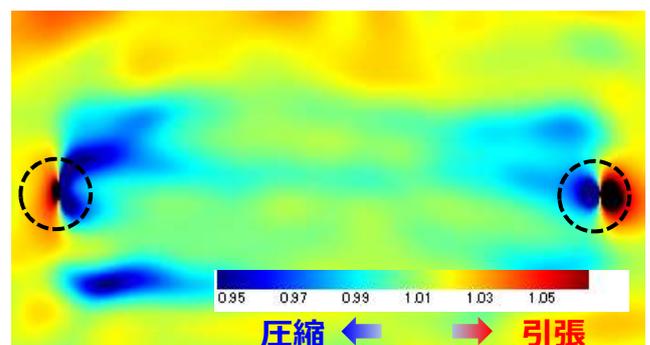
正常部 積層欠陥部

TEMを用いた解析、評価 (SiC)

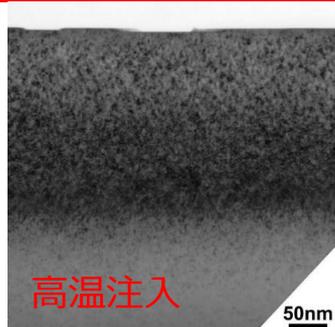
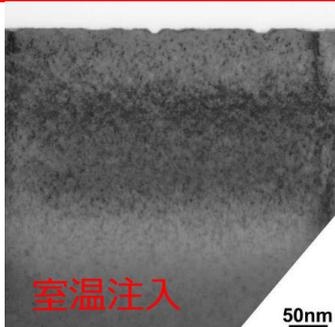
<SiC半導体の積層欠陥の解析結果>



< SiC半導体の歪みマッピング評価結果>



TEMを用いた解析、評価 (GaN)



高温注入により基板表面の平坦性が維持されています